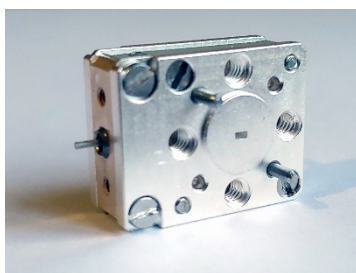


ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ АТТЕНЮАТОРЫ



- **Малые начальные потери**
- **Высокое запыриание**
- **Широкая полоса частот**
- **Малые габаритные размеры**

Полупроводниковые широкополосные электрически управляемые аттенюаторы предназначены для управления амплитудой и модуляции СВЧ-сигнала в измерительных трактах, а так же в составе радиотехнической аппаратуры различного назначения в диапазоне частот 50 – 75 ГГц, 75 – 110 ГГц и 110 – 170 ГГц.

В качестве активного элемента аттенюатора использован полупроводниковый диод с n-i-p-i-n - структурой, что позволяет создавать аттенюатор с относительной полосой частот до 40%. Толщина i-слоя диода составляет 150 мкм, что дает возможность увеличить уровень допустимой коммутируемой СВЧ-мощности. За счет поглощения в диоде СВЧ-мощности в режиме инжекции аттенюаторы имеют малый коэффициент отражения. КСВН аттенюаторов в диапазоне ослаблений до 40 дБ не превышает 4.

Типовые параметры аттенюаторов

| Полоса частот, ГГц | 50-75 | 75-110 | 110-170 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| Начальные потери, дБ (тип) | 0.5 | 1 | 2.5 |
| Максимальное запираение, дБ | | 40 | |
| КСВН (макс) | | 4 | |
| Время переключения, мкс. (макс) | | фронт 7 спад 25 | |
| Ток управления, мА (макс) | | 50 | |
| Волновод | WR 15 | WR 10 | WR6 |
| Волноводный фланец | | UG387/UM | |
| Разъем управления | Герметичный низкочастотный вывод/SMA | | |
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 ÷ +40 | | |

Результаты измерений параметров аттенюатора

| Ток управления, мА | Потери пропускания, дБ |
|--------------------|------------------------|
| 0 | -1 |
| 2 | -5 |
| 5 | -10 |
| 10 | -20 |
| 16 | -30 |
| 25 | -40 |
| 30 | -44 |

